

表 サムスン電子の分野別投資計画の概要

分野	概要
半導体	(1)メモリー:14ナノ以下のDRAM、200層以上のNAND型フラッシュなどの開発を通じ技術・価格において競争力を維持する。 (2)システム半導体:開発工程への投資を強化し、GAA(注1)などの新技術を取り入れ、3ナノ以下のシステム半導体の早期量産を図る。
バイオ	(1)CDMO(注2):国内での第5工場および第6工場を新たに建設し、バイオ医薬品のほか、ワクチンや細胞・遺伝子治療薬などの次世代治療薬のCDMOに進出する。 (2)バイオシミラー(注3):持続的に開発(パイプライン)を拡大し、高度化に向けて集中的に投資する。
次世代通信	ネットワークの仮想化や基地局のオープン化など次世代通信ネットワーク技術に関する重要人材の確保および研究開発投資を拡大し、従来のRAN/Core事業以外に通信装置および次世代ネットワーク運営ソリューションなどを拡大する。
第4次産業革命	(1)人工知能:「グローバルAIセンター」を通じた技術開発を高性能AIアルゴリズムを採用した知能型機器に拡大し、研究開発と事業化の双方において競争力を確保する。 (2)ロボット:「ロボットの日常化」を推進し、スーパーコンピュータを活用した設計・開発を行う。 (3)ディスプレイ・バッテリー:次世代OLED(有機EL)・量子ディスプレイの事業化と高エネルギー密度バッテリーおよび全固体電池などの開発を強化する。

(注1) Gate All Aroundの略。シリコン面積あたりのトランジスタ密度を高めるデバイス技術。

(注2) Contract Development and Manufacturing Organizationの略。製薬会社から医薬品の開発・量産を受託する医薬品製剤開発・製造支援事業。

(注3) 先発のバイオ医薬品の特許が切れた後に発売されるバイオ医薬品。

(出所)サムスン電子プレスリリース